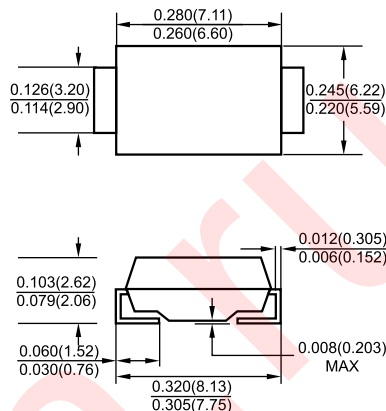




Особенности

- ❖ Запасивированный стеклом переход.
- ❖ Для поверхностного монтажа.
- ❖ Низкопрофильный корпус.
- ❖ Идеально подходит для автоматического размещения.
- ❖ Легко выбрать место для монтажа.
- ❖ Ультра-быстрое время восстановления для высокой эффективности.
- ❖ Высокая температура пайки: 260°C/10 секунд на вывод.
- ❖ Пластиковые материалы UL классификация пажарбезопасности 94V-0



Размеры в дюймах (миллиметрах).

Механические данные

- ❖ Корпус: литой пластиковый корпус JEDEC DO-214AB.
- ❖ Вывода: луженная припоем латунь.
- ❖ Полярность: цветовая маркировка обозначает катод.
- ❖ Вес: 0.21 грамм

Максимальные технические и электрические характеристики.

Значения параметров при 25°C температуре окружающей среды, если не указано иное. Однофазный, напряжение (В) половина волны, частота – 50 Гц, для резистивных и индуктивных нагрузок. Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%.

		ES 3A	ES 3B	ES 3C	ES 3D	ES 3F	ES 3G	ES 3H	ES 3J		
Макс.пиковое импульсное обратное напряжение	V_{RRM}	50	100	150	200	300	400	500	600	В	
Макс.среднеквадратическое значения напряж.	V_{RMS}	35	70	105	140	210	280	350	420	В	
Макс.постоянное запирающее напряжение	V_{DC}	50	100	150	200	300	400	500	600	В	
Максимальный средний прямой выпрямленный ток @ $T_L = 100^{\circ}C$	$I_{(AV)}$	3.0								A	
Максимальный прямой ток импульса в течении 8.3 мсек. одиночная полусинусоидальная волна, наложенная на номинальную нагрузку @ $T_L=100^{\circ}C$	I_{FSM}	100								A	
Максимальное падение напряжения на открытом диоде при прямом токе 2.0 А	V_F	0.95				1.3		1.7		B	
Макс.постоянный обратный ток при номинальном пост. обратном напряжении	I_R	@ $T_A=25^{\circ}C$ 10 @ $T_A=125^{\circ}C$ 500								мкА	
Макс.время обратного восстановления (Прим. 1)	T_{rr}	35								нсек	
Типичная емкость перехода (Прим. 2)	C_j	45				30				пФ	
Максимальное тепловое сопротивление (Прим. 3)	$R_{\theta JA}$ $R_{\theta JL}$					47 12					$^{\circ}C / Вт$
Диапазон рабочих температур	T_J	-55 to +150								$^{\circ}C$	
Диапазон температур хранения	T_{STG}	-55 to +150								$^{\circ}C$	

Примечание: 1. Измерено с $I_F=0.5\text{A}$, $I_R=1\text{A}$, $I_{rr}=0.25\text{A}$.
 2. Измеряется на частоте 1.0 МГц и обратном постоянном напряжении 4,0 В.
 3. Установленный на медную площадку 0.6x0.6" (16x16 мм) печатной платы.

ES3A-ES3J

SMD супербыстрый диод

Рис.1 - График снижения выходного тока

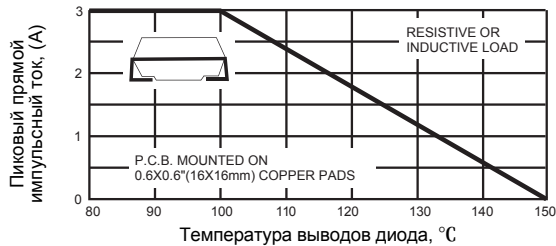


Рис.2 - Максимальный неповторяющийся пиковый ударный прямой ток

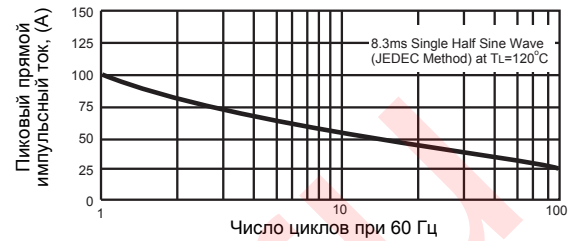


Рис.3 - Типичная прямая характеристика

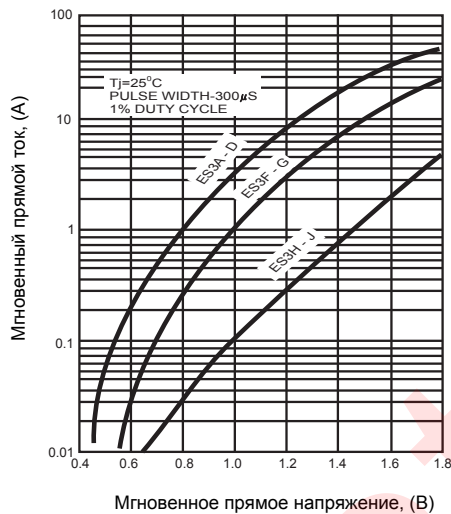


Рис.4 - Типичная обратная характеристика

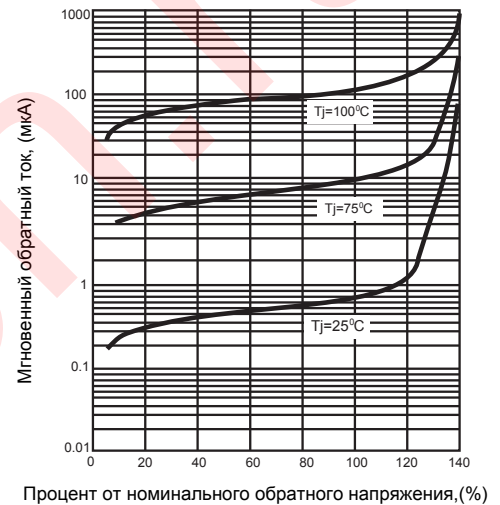


Рис.4 - Типичная емкость перехода

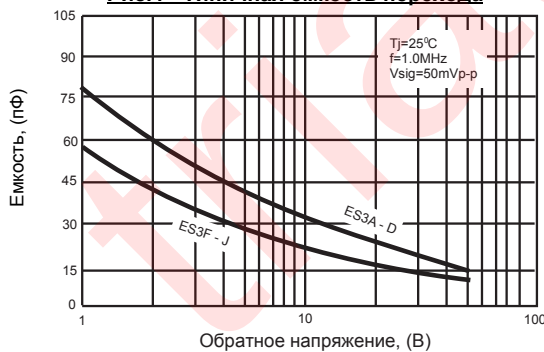


Рис.6 - Типичное переходное тепловое сопротивление

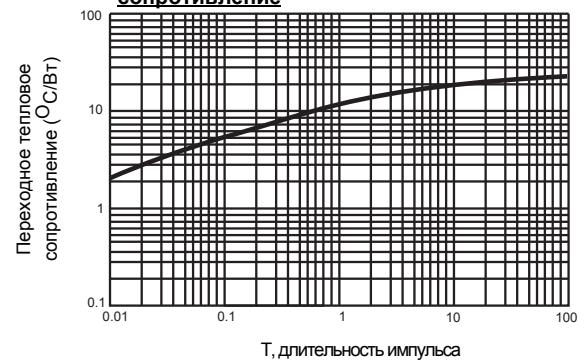
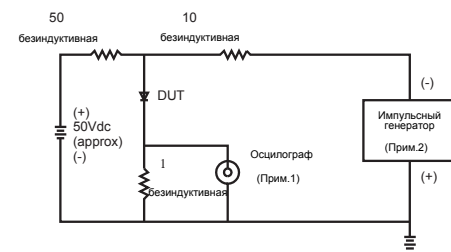


Рис.6 - Схема испытательной цепи для установления времени обратного восстановления



Примечания: 1. Время нарастания = 7нсек, макс. входное сопротивление = 1 Мом, 22пф.
2. Время нарастания = 10 нсек макс. сопротивление источника = 50 ом.

